

94-0147

Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано для получения чистых слоев InP с высокими воспроизводимыми электрофизическими параметрами.

Для снижения уровня неконтролируемого легирования и сокращения времени выхода в режим роста слоев с воспроизводимыми электрофизическими параметрами в способе получения слоев InP путем эпитаксиального наращивания в системе In-PCl₃-H₂ предварительно проводят термический отжиг индия в вакууме.

Технический результат заявляемого изобретения выражается в снижении уровня неконтролируемого легирования и сокращении времени выхода в режим роста слоев с воспроизводимыми электрофизическими параметрами.